――先端半導体デバイスの基礎と応用小特集（英文論文誌 C）論文募集――

先端半導体デバイスの基礎と応用小特集編集委員会

情報化社会の進展は，半導体集積回路・半導体デバイスの技術進歩無しには望めません．また，将来の知識基盤社会の構築にも，半導体デバイスの革新的な進歩に期待が寄せられています．微細化の限界を打破するためのシリコン ULSI デバイス技術，通信容量を格段に飛躍させる化合物半導体デバイス，新機能を創出する量子効果デバイスなど，半導体デバイスの大きな挑戦が進んでいます．最近では，化合物半導体とシリコンの融合集積化も研究が進められています．このような背景から，最先端半導体デバイスの研究動向を紹介することを目的に『先端半導体デバイスの基礎と応用』と題して小特集（平成 30 年 5 月号）を企画致しました．多くの方々の積極的な御投稿をお願い致します．

1. 対象分野

- 集積回路及び先端集積化技術
- 集積回路プロセス技術
- 高周波デバイスと回路応用
- パワーデバイス
- ワイドバンドギャップ材料とデバイス
- 新しい材料，デバイス，回路
- 半導体デバイス応用技術
- MOSFET，バイポーラトランジスタ，集積デバイス
- 化合物半導体材料とデバイス応用
- マイクロ波／ミリ波デバイス
- TFT の材料・デバイス・応用
- 量子効果デバイス，単電子デバイス
- 評価技術・シミュレーション技術
- センサ・ディスプレイ

2. 論文の執筆と取扱い

通常の英文論文と同一です．刷り上がりペーパー 8 ページ，ブリーフペーパー 4 ページ以内（厳守）を原則とします．詳細は Information for Authors（http://www.ieice.org/eng/shiori/mokuji_es.html）を御参照下さい．査読後の再提出期間（通常は 60 日）を短縮する場合がありますので，あらかじめ御了承下さい．投稿方法は下記を御参照下さい．

3. 投稿方法

査読作業の円滑化を図るため，本小特集では論文の電子投稿を行います．以下の手順で御投稿下さい．

https://review.ieice.org/regist/regist_baseinfo_e.aspx より登録を行って下さい．また，Web 上で著作権の譲渡手続きを行って下さい．なお登録時には必ず“Journal/Section”で［Special-FU］Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices を選択して下さい．［Regular-EC］を選択しないで下さい．

4. 論文投稿締切日　平成 29 年 8 月 25 日（金）厳守

5. 問合せ先

池田浩也
静岡大学電子工学研究所
TEL & FAX〔053〕478-1317，E-mail：ikeda.hiroya@shizuoka.ac.jp

6. 小特集編集委員会

委員長／ゲストエディタ：国清辰也（ルネサスエレクトロニクス）

幹　事：池田浩也（静大），新井　学（新日本無線）

委　員：佐道泰造（九大），岡田　浩（豊橋技科大），杉井寿博（富士通），野村晋太郎（筑波大），野口　隆（琉球大），松尾直人（兵庫県立大），小野行徳（静大），小林伸彰（日大），平本俊郎（東大），奈良安雄（兵庫県立大），大見俊一郎（東工大），宮崎誠一（名大），山口　直（ルネサスエレクトロニクス），黒田理人（東北大），津田邦男（東芝），鈴木寿一（北陸先端大），東脇正高（NICT），井田　実（NTT），大石敏之（佐賀大），大野雄高（名大），磯野僚多（サイオクス），重川直輝（大阪市立大），小谷淳二（富士通研），須原理彦（首都大），高谷信一郎（WIN Semiconductor），中田　健（住友電工），根来　昇（パナソニック），廣瀬文彦（山形大），宮本恭幸（東工大），山本佳嗣（三菱電機），岩田達哉（豊橋技科大），葛西誠也（北大），大野雄高（名大），藤代博記（東京理科大），川野陽一（富士通研）

7. 重要なお知らせ

- 論文採録の場合は掲載料が必要となりますので，あらかじめ御了承下さい．
- 投稿に際しては，著者のうち少なくとも 1 名は本会会員でなければなりません．ただし招待論文に関してはこの限りではありません．必要な投稿資格を満たしていない著者からの投稿論文については，投稿を受け付けないこととなりますので御注意下さい．入会の案内はこちらを御覧下さい．
  http://www.ieice.org/jpn/nyukai/index.html